

# 加工

(エッチング装置群)

## 反応性イオンエッチング装置

サムコ社製 RIE-10NR

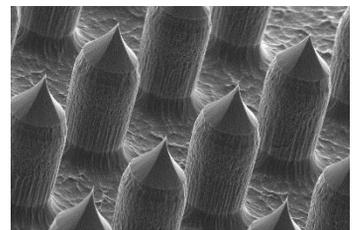
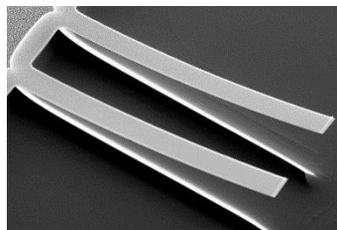
### 仕様

高周波電源	13.56MHz, 最大300W
電極構造	無遮蔽型平行平板電極 電極間距離55mm半固定
反応室	最大8インチウェハの加工が可能
使用ガス	O <sub>2</sub> 、SF <sub>6</sub> 、C <sub>2</sub> F <sub>6</sub> (腐食性ガスは使用不可)
エッチングレート	Si : 約 0.8mm/min SiO <sub>2</sub> : 約0.01mm/min



### 微細加工

Si、Poly-Si、SiO<sub>2</sub>、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>などの各種シリコン薄膜の高精度エッチングを目的としたRIE(リアクティブイオンエッチング)装置です。手動操作はもちろん、全自動運転が可能です。また、O<sub>2</sub>プラズマを使用することで、基板の表面改質、PDMSとガラスの接合、レジスト除去等の用途にも対応できます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp